









	<p>Hersteller-Teilenummer: IPD180N10N3GBTMA1</p>
	<p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 43A TO252-3</p>
	<p>Datenblätter:  IPD180N10N3GBTMA1.pdf</p>
<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
<p>Lieferung von: Hong Kong</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IPD180N10N3GBTMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 43A TO252-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 33µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO252-3
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	18 mOhm @ 33A, 10V
Verlustleistung (max)	71W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Andere Namen	IPD180N10N3 G
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1800pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	25nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 43A (Tc) 71W (Tc) Surface Mount PG-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	43A (Tc)

IPD180N10N3GBTMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPD180N10N3GBTMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPD180N10N3GBTMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPD180N10N3GBTMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPD200N15N3GATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 150V 50A TO252-3</p>	 <p>IPD180N10N3GATMA1 Infineon Technologies MV POWER MOS</p>	 <p>IPD180N10N3G INFINEO IPD180N10N3G INFINEO</p>	 <p>IPD200N15N3 G INFINEON IPD200N15N3 G INFINEON</p>
 <p>IPD2012-760 ICCNexergy (Inventus Power) 20 WATT DESKTOP POWER SUPPLY 12V</p>	 <p>IPD200N15N3G infineon IPD200N15N3G infineon</p>	 <p>IPD200N15N3GBTMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 150V 50A TO252-3</p>	 <p>IPD170N04NG INFINEON IPD170N04NG INFINEON</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPD180N10N3GBTMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPD180N10N3GBTMA1 Datenblatt	IPD180N10N3GBTMA1-Datenblätter	IPD180N10N3GBTMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPD180N10N3GBTMA1
IPD180N10N3GBTMA1 Electronic	IPD180N10N3GBTMA1-Komponenten	IPD180N10N3GBTMA1-Verteiler	IPD180N10N3GBTMA1-Bild	IPD180N10N3GBTMA1-Teil
IPD180N10N3GBTMA1 Preis	IPD180N10N3GBTMA1 Hersteller	IPD180N10N3GBTMA1 Bild	IPD180N10N3GBTMA1 Aktie	IPD180N10N3GBTMA1 Inventar
IPD180N10N3GBTMA1 Neu	IPD180N10N3GBTMA1 Original	IPD180N10N3GBTMA1 garantiert	IPD180N10N3GBTMA1 RFQ	IPD180N10N3GBTMA1 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited